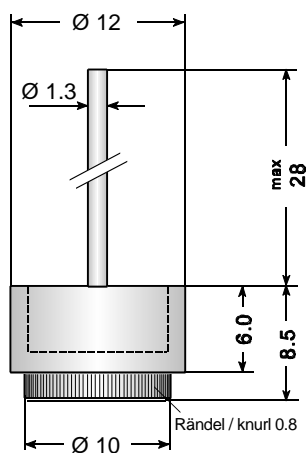


Fast Si-Press-Fit Diodes
Schnelle Si-Einpreßdioden


Anode to case / Gehäuse
Dimensions / Maße in mm

Nominal current – Nennstrom	20 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	50...200 V
Metal press-fit case with plastic cover Metall-Einpreßgehäuse mit Plastik-Abdeckung	
Weight approx. – Gewicht ca.	10 g
Casting compound has UL classification 94V-0 Vergußmasse UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging: bulk Standard Lieferform: lose im Karton	

Maximum ratings
Grenzwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]
KMSF 70	50	50
KMSF 71	100	100
KMSF 72	200	200

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschtung mit R-Last	$T_C = 100^\circ\text{C}$	I_{FAV}	20 A
Rating for fusing, $t < 10$ ms Grenzlastintegral, $t < 10$ ms	$T_A = 25^\circ\text{C}$	i^2t	600 A ² s
Peak forward surge current, single half sine-wave Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwell	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	350 A
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_s	– 50...+200°C – 50...+200°C
Maximum pressure – Maximaler Einpreßdruck			7 kN

Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur T_j – 50...+200°C
 Storage temperature – Lagerungstemperatur T_s – 50...+200°C

Maximum pressure – Maximaler Einpreßdruck 7 kN

Characteristics

Kennwerte

Forward voltage Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 20\text{ A}$	V_F	< 1.2 V
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	I_R	< 10 μA
Reverse recovery time Sperrverzug	$I_F = 0.5\text{ A}$ through/über $I_R = 1\text{ A}$ to/auf $I_R = 0.25\text{ A}$		t_{rr}	< 250 ns
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse			R_{thC}	< 1 K/W

